JC09 Rec'd PCT/PTO 13 OCT 2005,

DOCKET NO.: 279492US0PCT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Seigo WATANABE, et al.

SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION

FILED: HEREWITH

INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/JP04/05332

INTERNATIONAL FILING DATE: April 14, 2004

FOR: CATALYST FOR ACRYLONITRILE SYNTHESIS

REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119 AND THE INTERNATIONAL CONVENTION

Commissioner for Patents Alexandria, Virginia 22313

Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicant claims as priority:

COUNTRY Japan

APPLICATION NO

DAY/MONTH/YEAR

18 April 2003

Certified copies of the corresponding Convention application(s) were submitted to the International Bureau in PCT Application No. PCT/JP04/05332. Receipt of the certified copy(s) by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.

> Respectfully submitted, OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C.

Norman F. Oblon Attorney of Record Registration No. 24,618 Surinder Sachar

Registration No. 34,423

Customer Number 22850

(703) 413-3000 Fax No. (703) 413-2220 (OSMMN 08/03)

14. 4. 2004

REC'D 10 JUN 2004

PCT

WIPO

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年 4月18日

出 願 番 号
Application Number:

特願2003-114131

[ST. 10/C]:

44.1

[JP2003-114131]

出 願 人
Applicant(s):

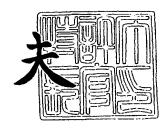
ダイヤニトリックス株式会社

PRIORITY

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 5月27日

今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

J11590A1

【提出日】

平成15年 4月18日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

B01J 23/16

C07C255/08

【発明の名称】

アクリロニトリル合成用触媒

【請求項の数】

3

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県横浜市鶴見区大黒町10番1号 ダイヤニトリ

ックス株式会社技術研究所内

【氏名】

渡辺 聖午

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県横浜市鶴見区大黒町10番1号 ダイヤニトリ

ックス株式会社技術研究所内

【氏名】

水谷 浩一

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県横浜市鶴見区大黒町10番1号 ダイヤニトリ

ックス株式会社技術研究所内

【氏名】

柳田 元男

【発明者】

【住所又は居所】

広島県大竹市御幸町20番1号 三菱レイヨン株式会社

中央技術研究所内

【氏名】

泉 仁子

【特許出願人】

【識別番号】

301057923

【氏名又は名称】 ダイヤニトリックス株式会社



【代理人】

【識別番号】 100064908

【弁理士】

【氏名又は名称】 志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】 100108578

【弁理士】

【氏名又は名称】 高橋 詔男

【選任した代理人】

【識別番号】 100089037

【弁理士】

【氏名又は名称】 渡邊 隆

【選任した代理人】

【識別番号】 100101465

【弁理士】

【氏名又は名称】 青山 正和

【選任した代理人】

【識別番号】 100094400

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴木 三義

【選任した代理人】

【識別番号】 100107836

【弁理士】

【氏名又は名称】 西 和哉

【選任した代理人】

【識別番号】 100108453

【弁理士】

【氏名又は名称】 村山 靖彦

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008707

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0112982

【プルーフの要否】

要



明細書

【発明の名称】 アクリロニトリル合成用触媒

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくともモリブデンを含む複合酸化物と、シリカとを含有 する粒子からなるアクリロニトリル合成用触媒であって、

当該触媒のバルク組成におけるMo/Si原子比をA、粒子の表面組成におけ るMo/Si原子比をBとしたときに、B/Aが0.6以下であることを特徴と するアクリロニトリル合成用触媒。

【請求項2】 前記バルク組成が、下記一般式(1)で表されることを特徴 とする請求項1に記載のアクリロニトリル合成用触媒。

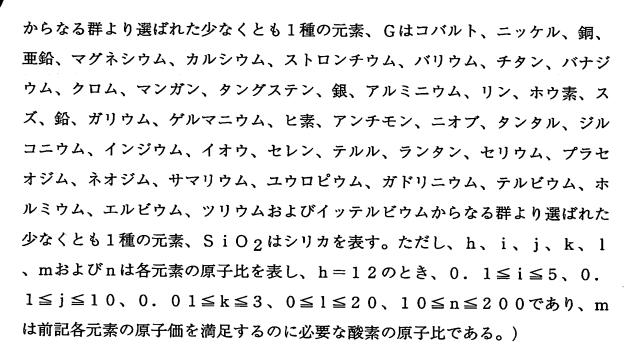
 $Sb_aMo_bC_cD_dE_eO_f$ (SiO₂) $_g\cdots$ (1)

(式中、Sb、MoおよびOはそれぞれアンチモン、モリブデンおよび酸素を表 し、Cは鉄、コバルト、ニッケル、マンガン、ウラン、セリウム、スズおよび銅 からなる群より選ばれた少なくとも1種の元素、Dはバナジウムおよびタングス テンからなる群より選ばれた少なくとも1種の元素、Eはマグネシウム、カルシ ウム、ストロンチウム、バリウム、ランタン、チタン、ジルコニウム、ニオブ、 タンタル、クロム、レニウム、ルテニウム、オスミウム、ロジウム、イリジウム 、パラジウム、白金、銀、亜鉛、カドミウム、ホウ素、アルミニウム、ガリウム 、インジウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、タリウム、ゲル マニウム、鉛、リン、ヒ素、ビスマス、セレンおよびテルルからなる群より選ば れた少なくとも1種の元素、SiO2はシリカを表す。ただし、a、b、c、d 、e、fおよびgは各元素の原子比を表し、a=10のとき、0.1≦b≦15 $1 \le c \le 20$, $0 \le d \le 10$, $0 \le e \le 20$, $10 \le g \le 200$ can fix 前記各元素の原子価を満足するのに必要な酸素の原子比である。)

【請求項3】 前記バルク組成が、下記一般式(2)で表されることを特徴 とする請求項1に記載のアクリロニトリル合成用触媒。

 $Mo_hBi_iFe_iF_kG_1O_m$ (SiO₂) $_n\cdots$ (2)

(式中、Mo、Bi、FeおよびOはそれぞれモリブデン、ビスマス、鉄および 酸素を表し、Fはナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウムおよびタリウム



【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、プロピレンを分子状酸素およびアンモニアにより気相接触アンモ酸 化してアクリロニトリルを合成する際に使用する触媒に関する。

[0002]

【従来の技術】

アクリロニトリル合成用触媒は、流動床アンモ酸化プロセスなどによりプロピレンからアクリロニトリルを合成するための触媒として広く知られ、現在世界各国で工業的に使用されているとともに、数多くの提案がなされている。

例えば、特許文献1~6には、モリブデンおよびビスマスを主成分とする触媒が開示されている。また、特許文献7には、モリブデンを含む触媒を用いて流動層でアクリロニトリルを製造する場合に、触媒のバルク組成におけるMoと他の金属成分との原子比を特定範囲内に維持することで、長時間に渡ってアクリロニトリル収率を高い水準に保つ方法が開示されている。

[0003]

【特許文献1】

特公昭61-13701号公報

【特許文献2】

特開昭59-204163号公報

【特許文献3】

特開平1-228950号公報

【特許文献4】

特開平10-43595号公報

【特許文献5】

特開平10-156185号公報

【特許文献6】

米国特許第5688739号明細書

【特許文献7】

特許第3217794号公報

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、特許文献1~6は、主に触媒の構成元素およびそのバルク組成 比を規定することで、活性、選択性等のいわゆる触媒初期特性を向上させようと するものであって、活性および選択性を長時間に渡って高い水準に保つような触 媒構造の設計技術については言及されていなかった。一方、特許文献7には、長 時間に渡ってアクリロニトリル収率を高い水準に保つ方法が開示されているもの の、この文献に開示されている方法だけでは未だ不十分であり、工業的見地から さらなる改良が必要であった。

[0005]

本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、プロピレンを気相接触アンモ酸化する際に、長時間に渡ってアクリロニトリル収率を高い水準に保つことのできるアクリロニトリル合成用触媒を提供することを課題とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、少なくともモリブデンを含む複合酸化物とシリカとを含有する 粒子状の触媒を用いて、例えば流動層反応器にて長時間の反応を継続した際に、 長時間に渡ってアクリロニトリル収率を高い水準に保つためには、触媒のバルク組成におけるMo/Si原子比に対する触媒粒子の表面組成におけるMo/Si原子比の比率をある値以下に制御することが重要であることを見出し、本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明のアクリロニトリル合成用触媒は、少なくともモリブデンを含む複合酸化物と、シリカとを含有する粒子からなるアクリロニトリル合成用触媒であって、当該触媒のバルク組成におけるMo/Sig于比をBとしたときに、B/Aが0.6以下であることを特徴とする。

[0007]

【発明の実施の形態】

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明のアクリロニトリル合成用触媒は、少なくともモリブデンを含む複合酸化物と、シリカとを含有する粒子からなり、プロピレンを分子状酸素およびアンモニアにより気相接触アンモ酸化してアクリロニトリルを合成する際に使用されるものであって、触媒のバルク組成におけるMo/Sig于比をA、粒子の表面組成におけるMo/Sig于比をBとしたときに、B/Aが0.6以下となるものである。

[0008]

ここで、触媒のバルク組成とは、少なくとも数十mgのアクリロニトリル合成 用触媒粒子の集合体全体の組成のことを指す。触媒のバルク組成におけるMo/Si原子比を測定する方法としては特に制限はないが、例えば、50mg以上の 触媒をフッ化水素酸と塩酸とヨウ化水素酸との混合液等に溶解させた後、その溶液をICP発光分光分析法により分析してMoおよびSiをそれぞれ定量し、Mo/Si原子比を算出する方法が好ましい。通常、触媒のバルク組成におけるMo/Si原子比は、触媒を調製する際に仕込んだ原料におけるこれらの比率と同じであると考えられる。

一方、粒子の表面組成とは、アクリロニトリル合成用触媒の各粒子におけるご く表層を構成している元素の比率のことを指す。ここで、ごく表層とは、粒子表



面から数nm程度の深さまでの層のことであり、X線光電子分光法(XPS法)により、X線源としてAl-ka線を使用して測定されたアクリロニトリル合成用触媒のXPSスペクトルから、まず、Mo3dのピーク面積強度とSi2pのピーク面積強度とを算出し、ついで、各々のピーク面積強度について装置固有の相対感度因子による補正を行ったうえで、これらの比率から算出したMo/Si原子比を「粒子の表面組成におけるMo/Si原子比」と定義する。

[0009]

B/Aが小さいものほど、これを使用してプロピレンの気相接触アンモ酸化を行った場合に、経時的なアクリロニトリル収率の低下、特にアクリロニトリル選択率の低下が小さくなり、特に、B/Aが0.6以下となるアクリロニトリル合成用触媒を使用してプロピレンの気相接触アンモ酸化を行うと、一層、経時的なアクリロニトリル収率の低下、特にアクリロニトリル選択率の低下が小さくなり、長時間に渡ってアクリロニトリル収率を高い水準に保つことができる。B/Aは0.45以下が好ましく、0.3以下が特に好ましい。

[0010]

アクリロニトリル合成用触媒の製造方法としては、少なくともモリブデンを含む複合酸化物と、シリカとを含有する粒子から構成され、B/Aが0.6以下であるアクリロニトリル合成用触媒が得られる方法であれば特に制限はないが、まず、モリブデンおよびシリカを含む水性スラリーを調製する工程と、この水性スラリーを乾燥する工程と、得られた乾燥物を焼成する工程とを有する方法が特に好ましい。

[0011]

水性スラリーの調製方法としては、水中に、少なくともモリブデン原料と、シリカとを添加し、撹拌すればよい。

水性スラリーを調製する際の液温については特に制限はないが、好ましくは60℃以下、より好ましくは45℃以下とする。液温が60℃を超えると、最終的に得られるアクリロニトリル合成用触媒のB/Aを0.6以下とすることが困難となる場合がある。

また、得られた水性スラリーには、必要に応じて70~105℃の範囲におい



て熟成、濃縮等の加熱処理を施してもよいが、最終的に得られるアクリロニトリル合成用触媒のB/Aを0.6以下とするためには、熟成、濃縮等の加熱処理は行わないことが好ましい。

[0012]

水性スラリーの調製に使用するモリブデン原料としては特に制限はなく、パラモリブデン酸アンモニウム、二モリブデン酸アンモニウム、三酸化モリブデン、二酸化モリブデン、モリブデン酸、塩化モリブデン等を使用できる。

また、モリブデンおよびシリカのほかに使用する原料の種類によっては、その原料の水への溶解度を調製するための成分を水性スラリーに添加してもよく、例えば硝酸塩を使用する場合には、硝酸を水性スラリー中0.1~4質量%の濃度となるように使用してもよい。

[0013]

シリカ原料としては、コロイダルシリカ(シリカゾル)が好ましく、市販のものを適宜選択して使用できる。また、コロイダルシリカにおけるコロイド粒子の大きさ(直径)には特に制限はないが、 $2\sim100\,\mathrm{n}\,\mathrm{m}$ が好ましく、 $5\sim50\,\mathrm{n}\,\mathrm{m}$ が特に好ましい。また、コロイド粒子の大きさは、均一であっても数種類の大きさのもが混ざったものであってもどちらでもよい。

また、水性スラリーに使用する水の量としては、水性スラリーの固形分濃度が 10~40質量%となるような量が好ましく、15~30質量%となるような量 がさらに好ましい。

[0014]

また、このような水性スラリーは、モリブデン、シリカ以外の他の成分を含んでいてもよい。

具体的には、最終的に得られるアクリロニトリル合成用触媒のより好ましいバルク組成としては、下記一般式(1)または(2)で表される組成が挙げられるので、このようなバルク組成となるように、式(1)中、C、D、Eで示される元素やSbの原料(例えば、その元素の硝酸塩、炭酸塩、酢酸塩、アンモニウム塩、酸化物、ハロゲン化物等)や、式(2)中、F、Gで示される元素やBiおよびFeの原料(例えば、その元素の硝酸塩、炭酸塩、酢酸塩、アンモニウム塩



、酸化物、ハロゲン化物等)をあらかじめ水性スラリーに添加しておくことが好ましい。

[0015]

 $Sb_aMo_bC_cD_dE_eO_f$ (SiO₂) g··· (1)

(式中、Sb、MoおよびOはそれぞれアンチモン、モリブデンおよび酸素を表し、Cは鉄、コバルト、ニッケル、マンガン、ウラン、セリウム、スズおよび銅からなる群より選ばれた少なくとも1種の元素、Dはバナジウムおよびタングステンからなる群より選ばれた少なくとも1種の元素、Eはマグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、ランタン、チタン、ジルコニウム、ニオブ、タンタル、クロム、レニウム、ルテニウム、オスミウム、ロジウム、イリジウム、パラジウム、白金、銀、亜鉛、カドミウム、ホウ素、アルミニウム、ガリウム、インジウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、タリウム、ゲルマニウム、鉛、リン、ヒ素、ビスマス、セレンおよびテルルからなる群より選ばれた少なくとも1種の元素、SiO2はシリカを表す。ただし、a、b、c、d、e、fおよびgは各元素の原子比を表し、a=10のとき、0.1 \leq b \leq 15、1 \leq c \leq 20、0 \leq d \leq 10、0 \leq e \leq 20、10 \leq g \leq 200であり、fは前記各元素の原子価を満足するのに必要な酸素の原子比である。)

[0016]

 $Mo_hBi_iFe_jF_kG_lO_m$ (SiO₂) $_n\cdots$ (2)

(式中、Mo、Bi、Fe およびOはそれぞれモリブデン、ビスマス、鉄および酸素を表し、Fはナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウムおよびタリウムからなる群より選ばれた少なくとも1種の元素、Gはコバルト、ニッケル、銅、亜鉛、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、チタン、バナジウム、クロム、マンガン、タングステン、銀、アルミニウム、リン、ホウ素、スズ、鉛、ガリウム、ゲルマニウム、ヒ素、アンチモン、ニオブ、タンタル、ジルコニウム、インジウム、イオウ、セレン、テルル、ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジム、サマリウム、ユウロピウム、ガドリニウム、テルビウム、ホルミウム、エルビウム、ツリウムおよびイッテルビウムからなる群より選ばれた少なくとも1種の元素、SiO2はシリカを表す。ただし、h、i、j、k、1



、mおよび n は各元素の原子比を表し、h=12のとき、 $0.1 \le i \le 5$ 、 $0.1 \le j \le 10$ 、 $0.01 \le k \le 3$ 、 $0 \le l \le 20$ 、 $10 \le n \le 200$ であり、mは前記各元素の原子価を満足するのに必要な酸素の原子比である。)

[0017]

このようにして得られた水性スラリーを、ついで乾燥する。乾燥方法としては特に制限はないが、得られる乾燥物の形状としては球形が好ましく、また、その粒径の調節が比較的容易であること、さらには得られるアクリロニトリル合成用触媒のB/Aを0.6以下に制御しやすいことから、スプレー乾燥機、特に、回転円盤型スプレー乾燥機、圧力ノズル型スプレー乾燥機、二流体ノズル型スプレー乾燥機等が好ましく用いられる。また、乾燥物の外径は、1~200μmが好ましく、5~150μmが特に好ましい。

この際、スプレー乾燥機乾燥室内に流通させる熱風の温度は、得られるアクリロニトリル合成用触媒のB/Aに影響を与えやすいことから、これを特定に制御することが好ましい。具体的には、スプレー乾燥機乾燥室内に流通させる熱風は、乾燥室内への導入口付近における温度が130~350 であることが好ましく、140~300 でがさらに好ましい。また、乾燥室出口付近における温度は100~200 でが好ましく、110~180 でがさらに好ましい。また、導入口付近における温度と乾燥室出口付近における温度との差は20~60 でに保たれていることが好ましく、25~45 でに保たれていることがさらに好ましい。

[0018]

ついで、得られた乾燥物を焼成することにより、アクリロニトリル合成用触媒 が得られる。

焼成温度としては特に制限はないが、乾燥物を500~750℃の範囲の温度で焼成することにより、望ましい触媒活性構造が形成され、得られた触媒を使用してプロピレンのアンモ酸化を行った場合に、高いアクリロニトリル収率を長時間に渡って維持することができる。また、500~750℃での焼成する前に、より低温での予備焼成を行うことが好ましい。予備焼成は、例えば、250~400℃程度の温度、または、400~500℃程度の温度のいずれか一方の条件で行ってもよいし、両方の条件で行ってもよい。このように1~2段階の予備焼



成を行った後、500~750℃の範囲の温度で焼成を行うと、非常に望ましい 触媒活性構造が形成され、得られた触媒を使用してプロピレンのアンモ酸化を行った場合に、高いアクリロニトリル収率を長時間に渡って維持することができる

焼成時間についても特に制限はないが、1時間以上焼成することが好ましい。 1時間未満では、良好な触媒活性構造が形成されない場合がある。具体的には、 1時間以上予備焼成した後、1時間以上500~750℃で焼成することが好ま しい。

焼成方法についても特に制限はなく、汎用の焼成炉を用いることができるが、 ロータリーキルン、流動焼成炉等が特に好ましく用いられる。

焼成雰囲気としては、空気が特に好ましく用いられるが、窒素、二酸化炭素等 の不活性ガス、窒素酸化物、水蒸気等を一部含んでいてもよい。

[0019]

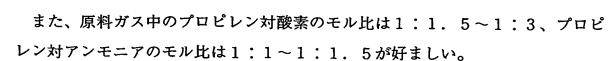
このようにして得られたアクリロニトリル合成用触媒の粒子形状および大きさについては特に制限はないが、形状は球形が特に好ましく、また、その外径は $1\sim200\,\mu\,\mathrm{m}$ が好ましく、 $5\sim150\,\mu\,\mathrm{m}$ が特に好ましい。

[0020]

得られたアクリロニトリル合成用触媒を用いて、プロピレンを分子状酸素およびアンモニアにより気相接触アンモ酸化してアクリロニトリルを合成する方法としては、特に制限はないが、流動床反応器を用いることが好ましく、アクリロニトリル合成用触媒を流動床反応器に投入した後、例えば400~500℃、常圧~300kPaの条件下において、少なくとも分子状酸素とアンモニアとプロピレンとを含有し、必要に応じて不活性ガスや水蒸気で希釈された原料ガスを流動床反応器に流通させることにより、プロピレンが気相接触アンモ酸化されアクリロニトリルが生成する。

原料ガス中のプロピレンの濃度は広い範囲で変えることができ、 $1\sim20$ 容量%が適当であり、特に $3\sim15$ 容量%が好ましい。

原料ガスに使用する酸素源としては、空気を用いることが工業的には有利であるが、必要に応じて純酸素を空気と混合し空気を富化して使用してもよい。



[0021]

以上説明したように、少なくともモリブデンを含む複合酸化物と、シリカとを含有する粒子からなるアクリロニトリル合成用触媒であって、触媒のバルク組成におけるMo/Si原子比をA、粒子の表面組成におけるMo/Si原子比をBとしたときに、B/Aが0.6以下であるアクリロニトリル合成用触媒によれば、プロピレンを気相接触アンモ酸化する際に、長時間に渡ってアクリロニトリル収率を高い水準に保つことができる。

[0022]

このように触媒のバルク組成におけるMo/Si原子比(=A)と、粒子の表面組成におけるMo/Si原子比(=B)との比率B/Aを特定の範囲以下とすることにより高いアクリロニトリル収率を長時間に渡って維持できる理由については明らかではないが、B/Aが小さいということは、その触媒の粒子構造において粒子表面近傍に選択的にシリカが濃縮されているということであり、また同時に、粒子表面へのMoの露出が少ないということである。よって、触媒粒子がそのような構造をとることにより、反応使用時における昇華および/または磨耗による触媒からのMo成分の散逸が効果的に低減されている可能性が考えられる

一般に、触媒は、その粒子構造内において構成元素ができるだけ均一に分布していることが望ましいとされている例が多いが、このように粒子表面近傍に選択的にシリカが濃縮されている方が長時間に渡ってアクリロニトリル収率を高い水準に保てるという知見は非常に興味深い。

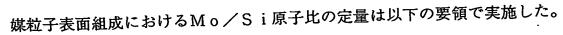
[0023]

【実施例】

以下、本発明を実施例を示して具体的に説明する。ただし、下記実施例および比較例中の「部」は質量部を意味する。

[0024]

触媒の活性試験、触媒のバルク組成におけるMo/Si原子比の定量および触



(1) 触媒の活性試験

塔径2インチの流動床反応器を用いてプロピレンをアンモ酸化して、アクリロニトリルを合成した。

原料ガスとしては、プロピレン/アンモニア/空気/水蒸気=1/1.2/9.5/0.5(モル比)の混合ガスを用い、これをガス線速度18cm/秒で反応器内に導入した。反応温度は430 \mathbb{C} 、反応圧力は200 KP a とした。

反応ガスの分析(反応試験分析)はガスクロマトグラフィーにより行った。 また、接触時間、プロピレンの転化率、アクリロニトリルの選択率およびアク リロニトリルの収率は以下のように定義される。

接触時間(秒)=かさ密度基準の触媒容積(L)/反応条件に換算した供給ガス流量(L/秒)

プロピレンの転化率 (%) = Q/P×100

アクリロニトリルの選択率 (%) = R/Q×100

アクリロニトリルの収率 (%) = R / P×100

なお、Pは供給したプロピレンのモル数、Qは反応したプロピレンのモル数、 Rは生成したアクリロニトリルのモル数を表す。

[0025]

(2) 触媒のバルク組成におけるMo/Si原子比の定量

触媒 0.5 gに36質量%塩酸5mL、57質量%ヨウ化水素酸10mLおよび47質量%フッ化水素酸2.5 mLを順次加え、密封した状態で完全に溶解させた。

その後、ポリプロピレン製メスフラスコに移液し、標線まで水で希釈しサンプ ル液とした。

ついで、このサンプル液を適宜希釈した上で、ICP発光分光分析装置(日本ジャーレルアッシュ社製ICAP-577)を用いてMoおよびSiを定量し、その原子比を求めた。

[0026]

(3) 触媒粒子表面組成におけるMo/Si原子比の定量



測定により得られたXPSスペクトルについて、まず、Mo3dのピーク面積強度およびSi2pのピーク面積強度を算出し、次いで各々のピーク面積強度について装置固有の相対感度因子による補正を行ったうえでその比率を求めるという手順により、触媒粒子表面組成におけるMo/Si原子比を求めた。

[0027]

[実施例1]

20質量%コロイダルシリカ(コロイド粒子平均直径20nm)1915部に85質量%リン酸3.3部を加えた。この液に攪拌下、パラモリブデン酸アンモニウム212.5部を640部の水に溶解したものを加え、50℃に加温し、A液とした。

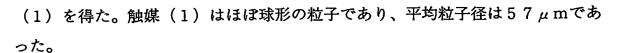
別に、10質量%硝酸105部に硝酸ビスマス105.2部を溶解し、この液 に硝酸ニッケル210.1部、硝酸鉄 (III) 87.6部、硝酸カリウム2. 9部および水312部を順次加え、50℃に加温し、B液とした。

さらに別に、61質量%硝酸 930.5 部を水 843 部と混合し、そこへ電解 鉄粉 104.7 部を少しずつ加え溶解させた。この液に三酸化アンチモン 324 .4 部を加え、100 で 2 時間加熱した。ついでこの液にホウ酸 10.2 部を 水 194 部に溶解したもの、および 85 質量%リン酸 8.9 部を加えた。得られ た液を乾燥した後、950 で 3 時間焼成し、更に粉砕した。得られた粉砕物 4 00 部に水 600 部を加え、ボールミルで 16 時間粉砕することにり、液状物を 得、50 でに加温した。これを C 液とする。

攪拌下、A液にB液を混合し、次いでC液831.1部を加え、スラリー状物を得た。

得られたスラリー状物を圧力ノズル型スプレー乾燥機にて、熱風の導入口における温度を200 \mathbb{C} 、出口における温度を160 \mathbb{C} にコントロールしながら乾燥した。乾燥物はほぼ球形の粒子であった。

ついで、得られた乾燥物を空気雰囲気下、250℃で2時間、次いで400℃ で2時間予備焼成した後、530℃で3時間流動焼成炉にて焼成することで触媒



[0028]

こうして得られた触媒 (1) のバルク組成は、原料仕込み量から以下のように 算出される。

 $Sb_{10}Mo_{8.}$ 5 Fe $_{10}Ni_{5}Bi_{1.}$ 5 Ko. 2 Bo. 75 Po. 55 O x (SiO₂) 45

(ここで、x は他の各元素の原子価を満足するのに必要な酸素の原子比である。)

触媒(1)について、バルク組成におけるMo/Si原子比をICP発光分光 分析法により測定したところ、0.19であった。この値は、上記原料仕込み量 から算出した原子比、すなわち 8.5/45と実質的に同じであった。

また、触媒(1)について、触媒粒子表面組成におけるMo/Si原子比をX線光電子分光法により測定したところ、0.08であった。

すなわち、触媒(1)において、バルク組成におけるMo/Si原子比に対する触媒粒子表面組成におけるMo/Si原子比の比率は0.42であった。

触媒(1)について、先に説明した活性試験を接触時間3.2秒で行ったところ、反応開始3時間後におけるプロピレンの転化率は97.4%、アクリロニトリルの選択率は84.0%、アクリロニトリルの収率は81.8%であった。

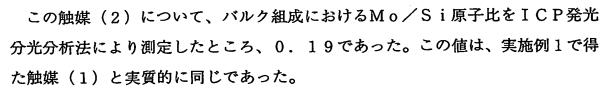
この反応をそのまま継続し、反応開始より500時間後に再び分析したところ、プロピレンの転化率は97.2%、アクリロニトリルの選択率は83.4%、アクリロニトリルの収率は81.1%であった。

[0029]

[比較例1]

実施例1と同様にしてスラリー状物を得、得られたスラリー状物を圧力ノズル型スプレー乾燥機にて、熱風の導入口における温度を330℃、出口における温度を190℃にコントロールしながら乾燥した。

次いで予備焼成することなくマッフル炉にて530℃で3時間焼成することで 触媒2を得た。



また、触媒(2)について、触媒粒子表面組成におけるMo/Si原子比をX線光電子分光法により測定したところ、0.13であった。

すなわち、触媒(2)において、バルク組成におけるMo/Si原子比に対する触媒粒子表面組成におけるMo/Si原子比の比率は0.68であった。

触媒(2)について、先に説明した活性試験を接触時間3.2秒にて行ったところ、反応開始3時間後におけるプロピレンの転化率は97.5%、アクリロニトリルの選択率は83.9%、アクリロニトリルの収率は81.8%であった。

この反応をそのまま継続し、反応開始より500時間後に再び分析したところ、プロピレンの転化率は96.9%、アクリロニトリルの選択率は82.4%、アクリロニトリルの収率は79.8%であった。

[0030]

[実施例2]

30質量%コロイダルシリカ(コロイド粒子平均直径25 nm)1650.1 部および水850部の混合液にパラモリブデン酸アンモニウム415.6部を溶 解し、40 $^{\circ}$ に加温し、D液とした。

別に、13質量%硝酸水溶液530部に、硝酸鉄(III)142.6部、硝酸ニッケル285.1部、硝酸コバルト57.1部、硝酸マグネシウム50.3 部、硝酸セリウム46.8部、硝酸ビスマス42.8部、硝酸カリウム1.6部 および硝酸ルビジウム1.7を溶解させ、40℃に加温し、E液とした。

D液をよく撹拌しながら、そこにE液を混合し、スラリー状物を得た。

得られたスラリー状物を回転円盤型スプレー乾燥機にて、熱風の導入口における温度を 220 \mathbb{C} 、出口における温度を 170 \mathbb{C} にコントロールしながら乾燥した。乾燥物はほぼ球形の粒子であった。

得られた乾燥物を、300℃で2時間、次いで450℃で2時間予備焼成した後、590℃で3時間流動焼成炉にて焼成することで触媒(3)を得た。触媒(3)はほぼ球形の粒子であり、平均粒子径は 58μ mであった。



[0031]

こうして得られた触媒 (3) のバルク組成は、原料仕込み量から以下のように 算出される。

Mo₁₂Bi_{0. 45}Fe_{1. 8}Ni₅Co₁Mg₁Ce_{0. 55}K_{0. 08}R b_{0. 06}O_x (SiO₂) 42

(ここで、x は他の各元素の原子価を満足するのに必要な酸素の原子比である。)

触媒(3)について、バルク組成におけるMo/Si原子比をICP発光分光 分析法により測定したところ、0.29であった。この値は、上記原料仕込み量 から算出した原子比、すなわち12/42と実質的に同じであった。

また、触媒(3)について、触媒粒子表面組成におけるMo/Si原子比をX線光電子分光法により測定したところ、0.10であった。

すなわち、触媒(3)において、バルク組成におけるMo/Si原子比に対する触媒粒子表面組成におけるMo/Si原子比の比率は0.34であった。

触媒(3)について、先に説明した活性試験を接触時間2.8秒にて行ったところ、反応開始3時間後におけるプロピレンの転化率は98.5%、アクリロニトリルの選択率は84.5%、アクリロニトリルの収率は83.2%であった。

この反応をそのまま継続し、反応開始より500時間後に再び分析したところ、プロピレンの転化率は98.4%、アクリロニトリルの選択率は83.9%、アクリロニトリルの収率は82.6%であった。

[0032]

[実施例3]

実施例 2 と同様にしてスラリー状物を得、得られたスラリー状物を圧力ノズル型スプレー乾燥機にて、熱風の導入口における温度を 180 $\mathbb C$ 、出口における温度を 145 $\mathbb C$ にコントロールしながら乾燥した。乾燥物はほぼ球形の粒子であった。

その後は実施例 2 と同様にして触媒(4)を得た。触媒(4)はほぼ球形の粒子であり、平均粒子径は 5 4 μ mであった。

この触媒(4)について、バルク組成におけるMo/Si原子比をICP発光

分光分析法により測定したところ、0.29であった。この値は、実施例2で得た触媒(3)と実質的に同じであった。

また、触媒(4)について、触媒粒子表面組成におけるMo/Si原子比をX線光電子分光法により測定したところ、0.05であった。

すなわち、触媒(4)において、バルク組成におけるMo/Si原子比に対する触媒粒子表面組成におけるMo/Si原子比の比率は0.17であった。

触媒(4)について、先に説明した活性試験を接触時間2.8秒にて行ったところ、反応開始3時間後におけるプロピレンの転化率は98.5%、アクリロニトリルの選択率は84.7%、アクリロニトリルの収率は83.4%であった。

この反応をそのまま継続し、反応開始より500時間後に再び分析したところ、プロピレンの転化率は98.4%、アクリロニトリルの選択率は84.3%、アクリロニトリルの収率は83.0%であった。

[0033]

[比較例2]

実施例2と同様にしてD液およびE液を調製した。ただし、D液およびE液の 温度を80℃に変更した。

D液をよく撹拌しながら、そこにE液を混合し、スラリー状物を得た。

得られたスラリー状物を回転円盤型スプレー乾燥機にて、熱風の導入口における温度を370 \mathbb{C} 、出口における温度を190 \mathbb{C} にコントロールしながら乾燥した。

次いで予備焼成することなくマッフル炉にて590℃で3時間焼成することで 触媒(5)を得た。

[0034]

触媒(5)について、バルク組成におけるMo/Si原子比をICP発光分光 分析法により測定したところ、0.29であった。この値は、実施例 2 および 3 で得た触媒(3)および(4)と実質的に同じであった。

また、触媒(5)について、触媒粒子表面組成におけるMo/Si原子比をX線光電子分光法により測定したところ、0.22であった。

すなわち、触媒 (5) において、バルク組成におけるMo/Si原子比に対す

る触媒粒子表面組成におけるMo/Si原子比の比率は0.76であった。

触媒(5)について、先に説明した活性試験を接触時間2.8秒にて行ったところ、反応開始3時間後におけるプロピレンの転化率は98.1%、アクリロニトリルの選択率は83.3%、アクリロニトリルの収率は81.7%であった。この反応をそのまま継続し、反応開始より500時間後に再び分析したところ、プロピレンの転化率は97.0%、アクリロニトリルの選択率は81.2%、アクリロニトリルの収率は78.8%であった。

[0035]

「比較例3]

実施例2と同様にしてD液およびE液を調製した。

D液をよく撹拌しながら、そこにE液を混合し、次いで95℃まで加温した後、同温度で3時間熟成し、スラリー状物を得た。

得られたスラリー状物を圧力ノズル型スプレー乾燥機にて、熱風の導入口における温度を310 \mathbb{C} 、出口における温度を230 \mathbb{C} にコントロールしながら乾燥した。

次いで予備焼成することなくマッフル炉にて590℃で3時間焼成することで 触媒(6)を得た。

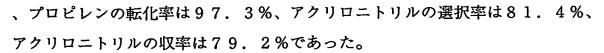
[0036]

この触媒(6)について、バルク組成におけるMo/Si原子比をICP発光 分光分析法により測定したところ、0.29であった。この値は、実施例 2 および 3 で得た触媒(3)および(4)と実質的に同じであった。

また、触媒(6)について、触媒粒子表面組成におけるMo/Si原子比をX線光電子分光法により測定したところ、0.21であった。

すなわち、触媒(6)において、バルク組成におけるMo/Si原子比に対する触媒粒子表面組成におけるMo/Si原子比の比率は0.72であった。

触媒(6)について、先に説明した活性試験を接触時間2.8秒にて行ったところ、反応開始3時間後におけるプロピレンの転化率は98.0%、アクリロニトリルの選択率は83.1%、アクリロニトリルの収率は81.4%であった。この反応をそのまま継続し、反応開始より500時間後に再び分析したところ



[0037]

【発明の効果】

以上説明したように本発明のアクリロニトリル合成用触媒によれば、プロピレンを分子状酸素およびアンモニアにより気相接触アンモ酸化してアクリロニトリルを合成する反応において、長時間に渡ってアクリロニトリル収率、特にアクリロニトリル選択率を高い水準に保つことができる。



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 プロピレンを気相接触アンモ酸化する際に、長時間に渡ってアクリロニトリル収率を高い水準に保つことのできるアクリロニトリル合成用触媒を提供する。

【解決手段】 少なくともモリブデンを含む複合酸化物と、シリカとを含有する粒子からなるアクリロニトリル合成用触媒であって、当該触媒のバルク組成におけるMo/Si原子比をA、粒子の表面組成におけるMo/Si原子比をBとしたときに、B/Aが0. 6以下であることを特徴とするアクリロニトリル合成用触媒である。

【選択図】 なし



認定・付加情報

特許出願の番号

特願2003-114131

受付番号

5 0 3 0 0 6 4 7 1 4 7

書類名

特許願

担当官

第六担当上席

0095

作成日

平成15年 4月21日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】

301057923

【住所又は居所】

東京都中央区京橋一丁目12番5号

【氏名又は名称】

ダイヤニトリックス株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】

100064908

【住所又は居所】

東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】

志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】

100101465

【住所又は居所】

東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】

青山 正和

【選任した代理人】

【識別番号】

100094400

【住所又は居所】

東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】

鈴木 三義

【選任した代理人】

【識別番号】

100107836

【住所又は居所】

東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】

西 和哉

【選任した代理人】

【識別番号】

100108453

【住所又は居所】

東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

次頁有



認定・付加情報(続き)

【氏名又は名称】

村山 靖彦

【選任した代理人】

【識別番号】

100108578

【住所又は居所】

東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】

高橋 詔男

【選任した代理人】

【識別番号】

100089037

【住所又は居所】

東京都新宿区高田馬場3丁目23番3号 ORビ

ル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】

渡邊 隆



特願2003-114131

出願人履歴情報

識別番号

[301057923]

1. 変更年月日 [変更理由]

2001年 8月28日

住所

新規登録 東京都中央区京橋一丁目12番5号

氏 名 ダイヤニトリックス株式会社